

# Elektronová Mikroskopie SEM

Martin Haničinec

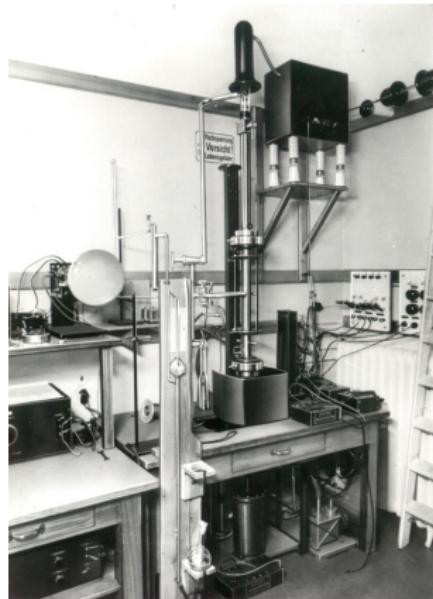
26. listopadu 2012

# Historie elektronové mikroskopie

- ▶ První TEM
- ▶ Ernst Ruska (1931)
- ▶ Nobelova cena za fyziku 1986



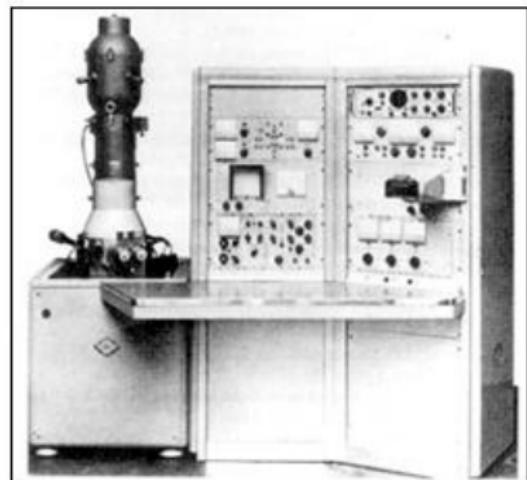
# Historie elektronové mikroskopie



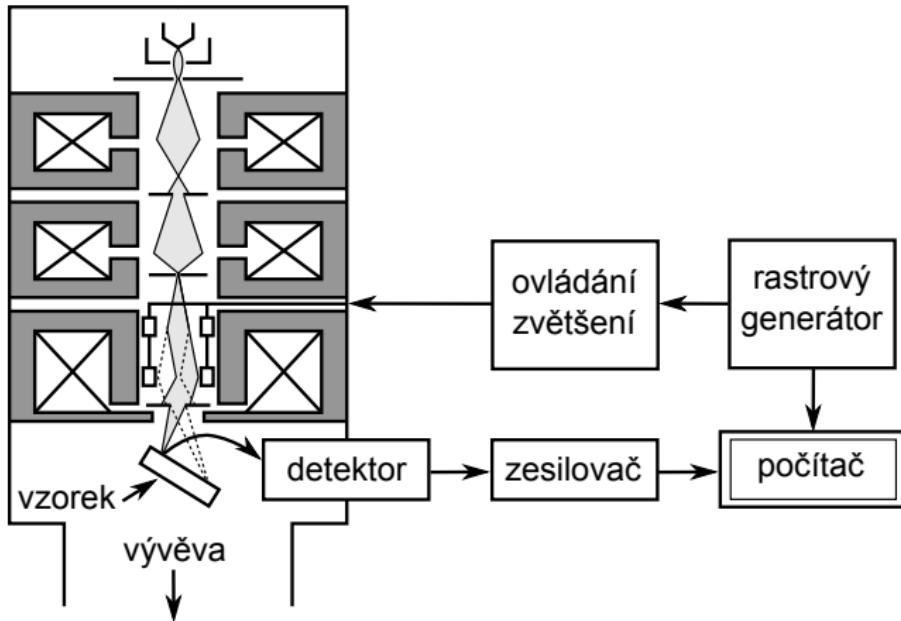
- ▶ První SEM
- ▶ Manfred von Ardenne (1937)

# Historie elektronové mikroskopie

- ▶ První komerční SEM
- ▶ Cambridge Scientific Instrument Company
- ▶ 1965



# Průřez elektronovým tubusem



# Elektronová tryska - typy emitorů

1. Wolfram - Termoemise
2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise
3. Wolfram - Schottkyho emise

# Elektronová tryska - typy emitorů

1. Wolfram - Termoemise
  - ▶ Nejnižší rozlišení
2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise
3. Wolfram - Schottkyho emise

# Elektronová tryska - typy emitorů

1. Wolfram - Termoemise
  - ▶ Nejnižší rozlišení
  - ▶ Nenáročné na vakuum
2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise
3. Wolfram - Schottkyho emise

# Elektronová tryska - typy emitorů

1. Wolfram - Termoemise
  - ▶ Nejnižší rozlišení
  - ▶ Nenáročné na vakuum
2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise
  - ▶ Vyšší rozlišení
3. Wolfram - Schottkyho emise

# Elektronová tryska - typy emitorů

## 1. Wolfram - Termoemise

- ▶ Nejnižší rozlišení
- ▶ Nenáročné na vakuum

## 2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise

- ▶ Vyšší rozlišení
- ▶ Potřeba čerpat prostor katody iontovou vývěvou

## 3. Wolfram - Schottkyho emise

# Elektronová tryska - typy emitorů

## 1. Wolfram - Termoemise

- ▶ Nejnižší rozlišení
- ▶ Nenáročné na vakuum

## 2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise

- ▶ Vyšší rozlišení
- ▶ Potřeba čerpat prostor katody iontovou vývěvou

## 3. Wolfram - Schottkyho emise

- ▶ Nejvyšší rozlišení

# Elektronová tryska - typy emitorů

## 1. Wolfram - Termoemise

- ▶ Nejnižší rozlišení
- ▶ Nenáročné na vakuum

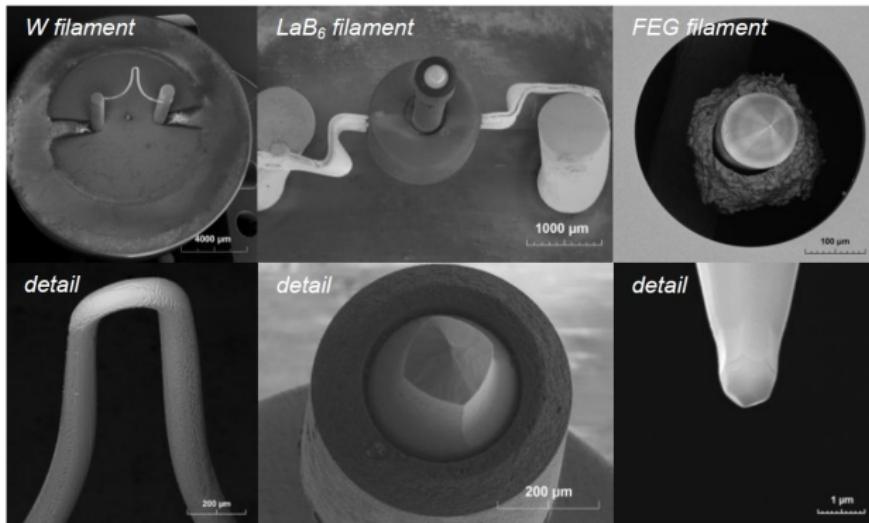
## 2. LaB<sub>6</sub> - Termoemise

- ▶ Vyšší rozlišení
- ▶ Potřeba čerpat prostor katody iontovou vývěvou

## 3. Wolfram - Schottkyho emise

- ▶ Nejvyšší rozlišení
- ▶ Potřeba čerpat prostor katody a tubusu 2 iontovými vývěvami

# Elektronová tryska - typy emitorů



# Schottkyho emise

- ▶ Ohmický ohřev velmi ostrého hrotu
- ▶ Typicky wolfram

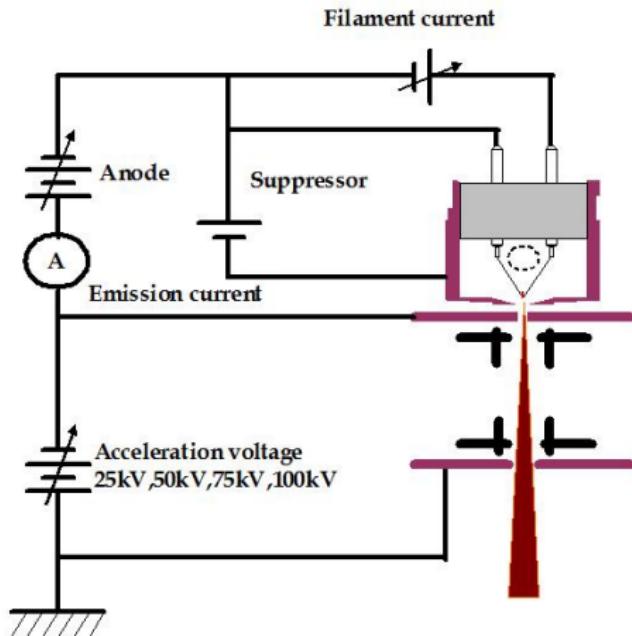
# Schottkyho emise

- ▶ Ohmický ohřev velmi ostrého hrotu
- ▶ Typicky wolfram
- ▶ Na povrchu hrotu vrstva ZrO
- ▶ Vysoká intenzita elektrického pole u povrchu hrotu

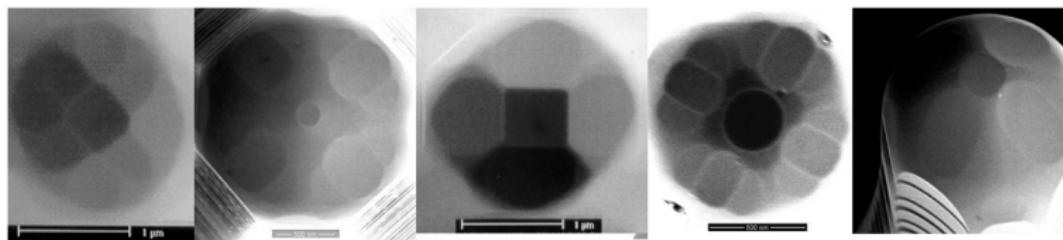
# Schottkyho emise

- ▶ Ohmický ohřev velmi ostrého hrotu
- ▶ Typicky wolfram
- ▶ Na povrchu hrotu vrstva ZrO
- ▶ Vysoká intenzita elektrického pole u povrchu hrotu
- ▶ Snížení výstupní práce elektronů z materiálu katody

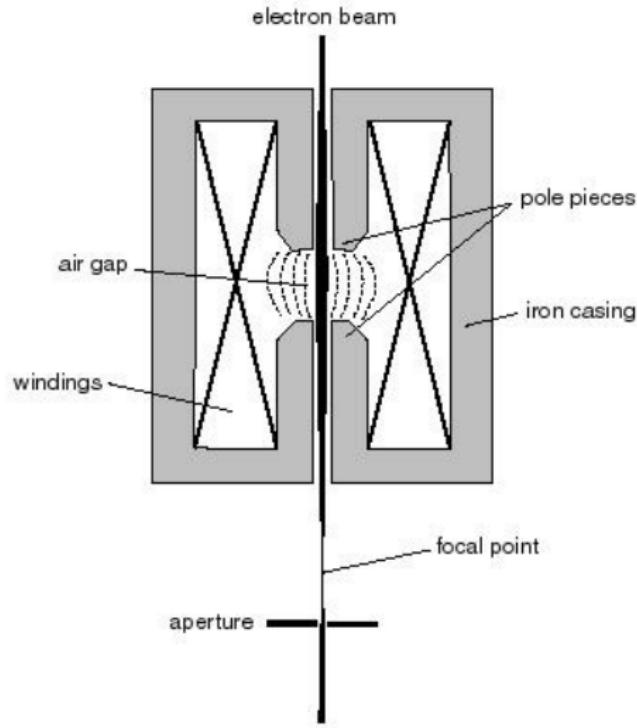
# Schottkyho emitor



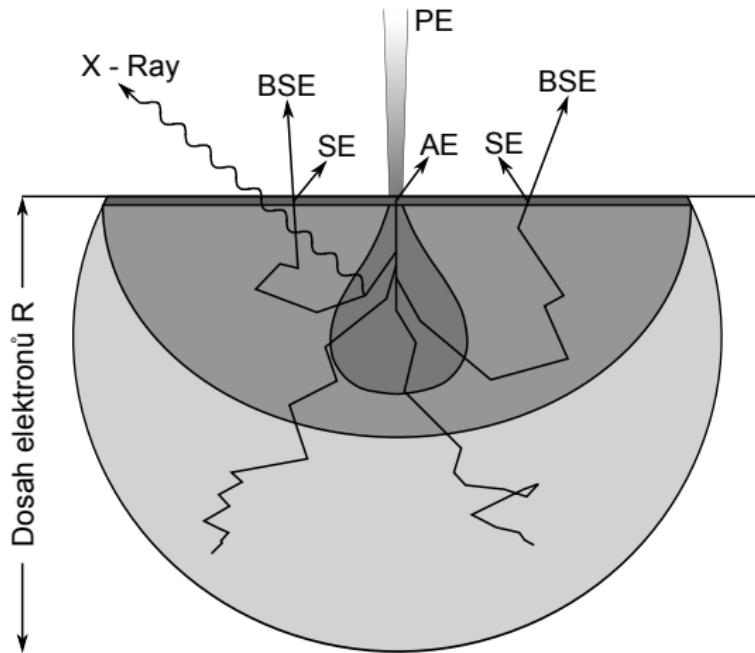
# Schottkyho emitor



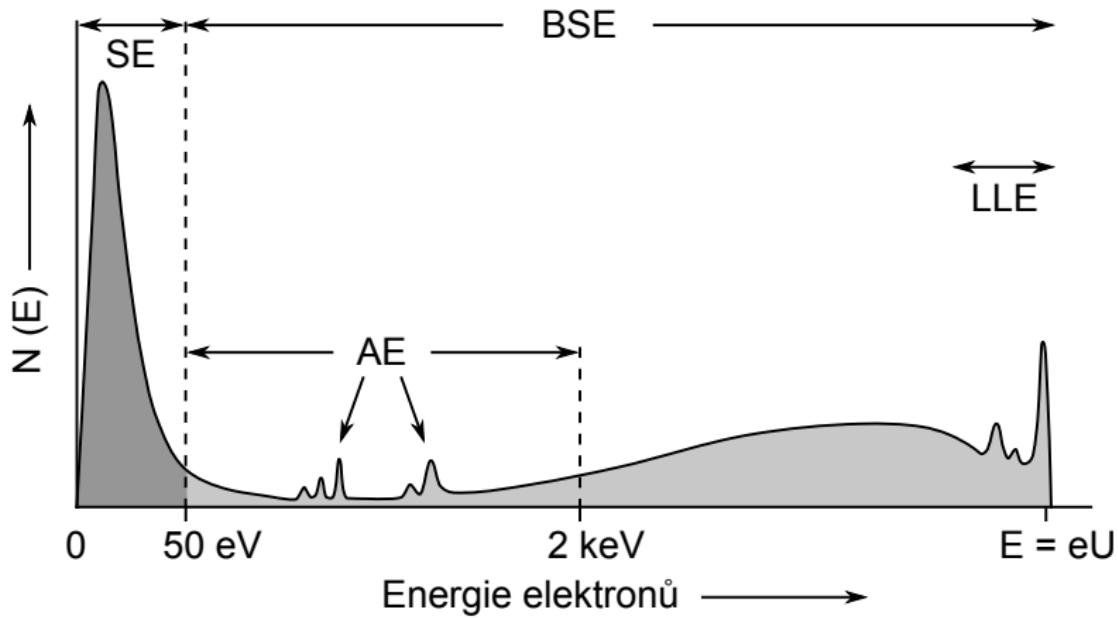
# Elektromagnetická čočka



# Interakce elektronů se vzorkem

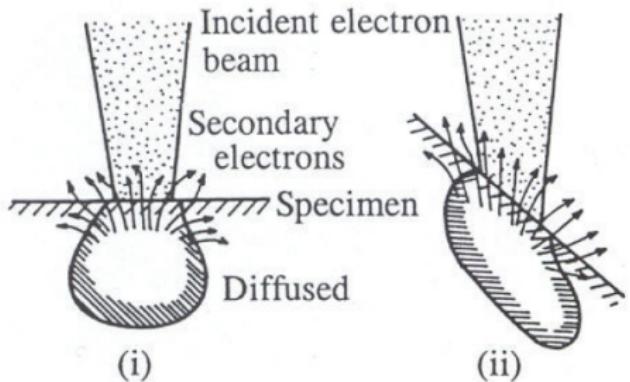


# Signální elektrony - energiové spektrum

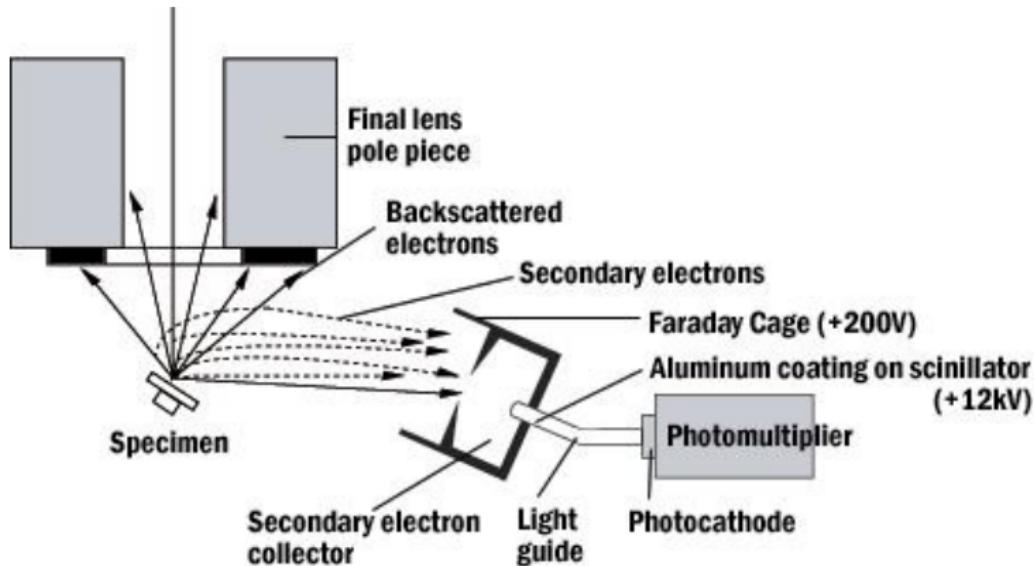


# Sekundární elektrony

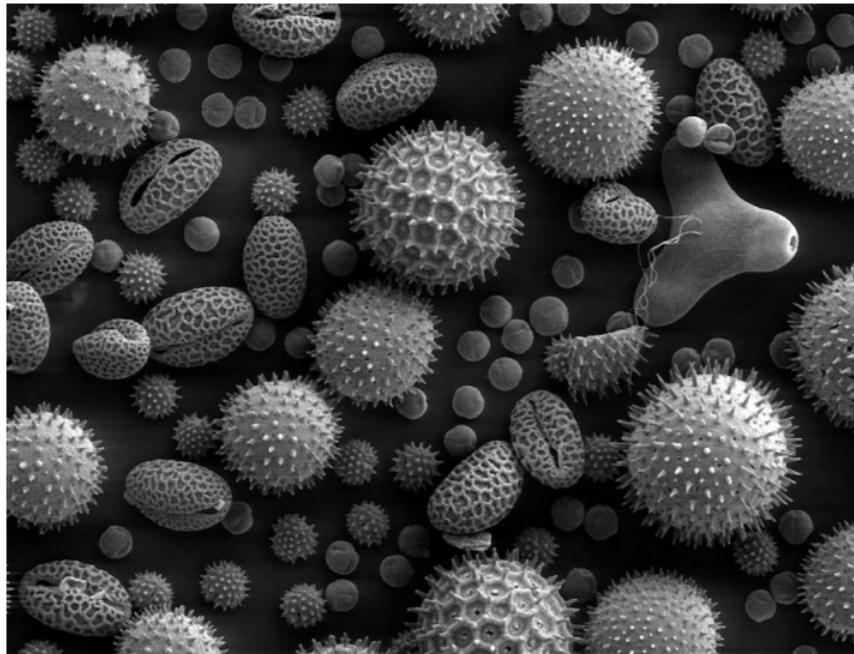
- ▶ Nesou topografický kontrast
- ▶ Intuitivní interpretace
- ▶  $\delta(\theta) = \frac{\delta_0}{\cos\theta}$
- ▶  $E < 50$  eV



# Sekundární elektrony - Everhard-Thornely detektor

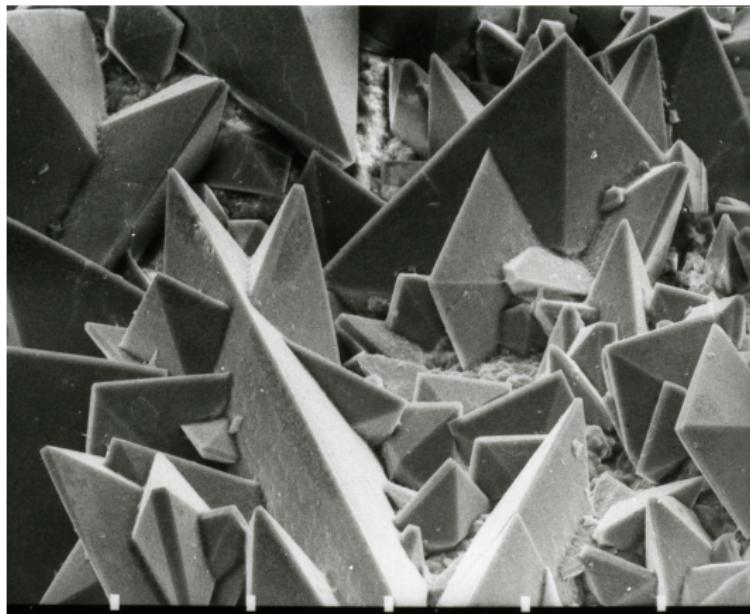


# Topografický kontrast - Obrázky



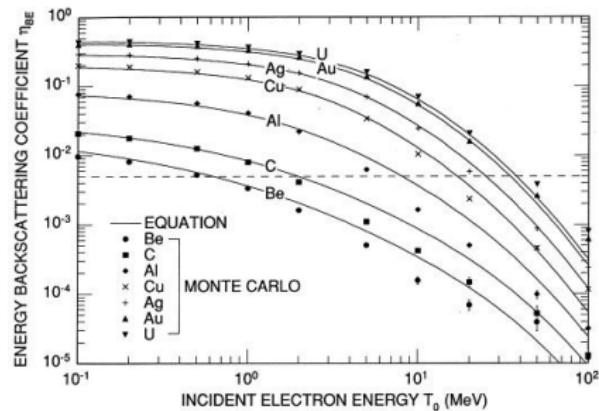
Obrázek: Zrnka pylu v signálu sekundárních elektronů.

# Topografický kontrast - Obrázky



Obrázek: Povrch ledvinového kamene v signálu sekundárních elektronů.

# Zpětně odražené elektrony

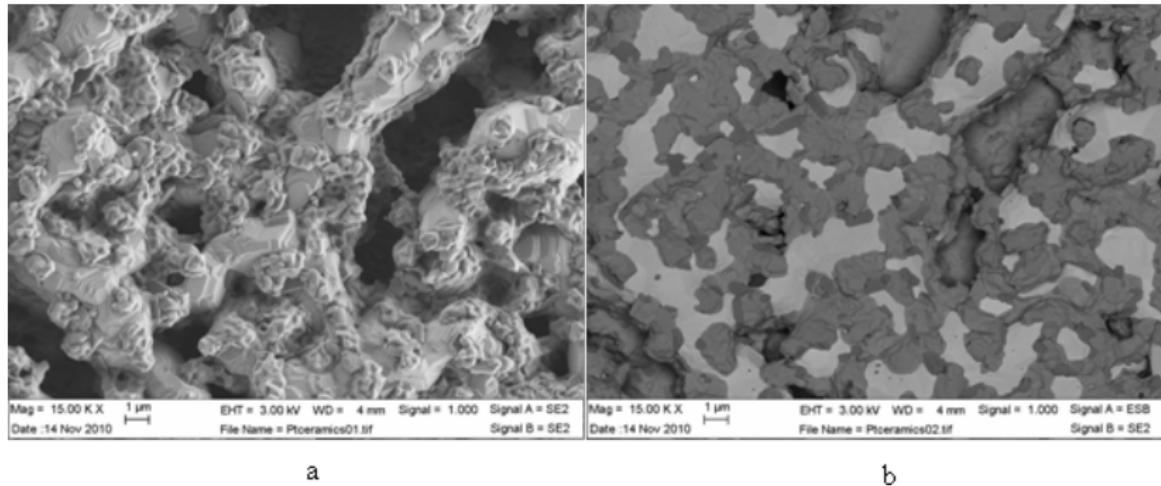


- ▶ Nesou materiálový kontrast
- ▶ Čím výšší  $Z$ , tím vyšší výtěžek
- ▶  $E > 50$  eV
- ▶ Také kanálovací kontrast

# BSE detektor



# Materiálový kontrast - Obrázky



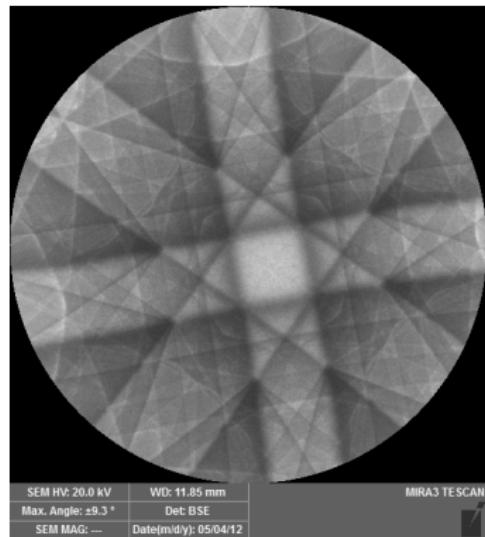
a

b

Obrázek: Srovnání topografického a materiálového kontrastu.

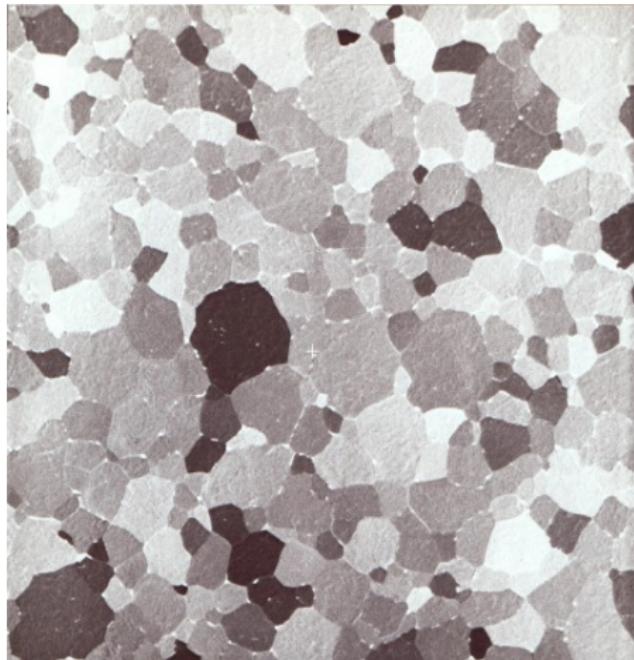
# Kanálovací kontrast (BSE)

- ▶ Naklánění svazkem v incidenčním bodu
- ▶ BSE signál na dvojici úhlů
- ▶ Výtěžek závisí na úhlu svazku a krystalografické roviny



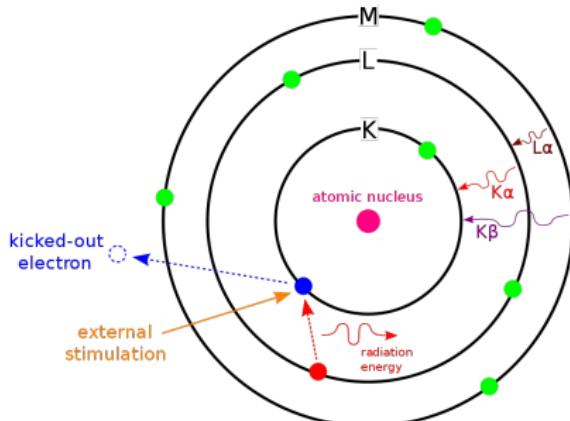
Obrázek: Kanálovací kontrast na c-Si.

## Kanálovací kontrast - Obrázky



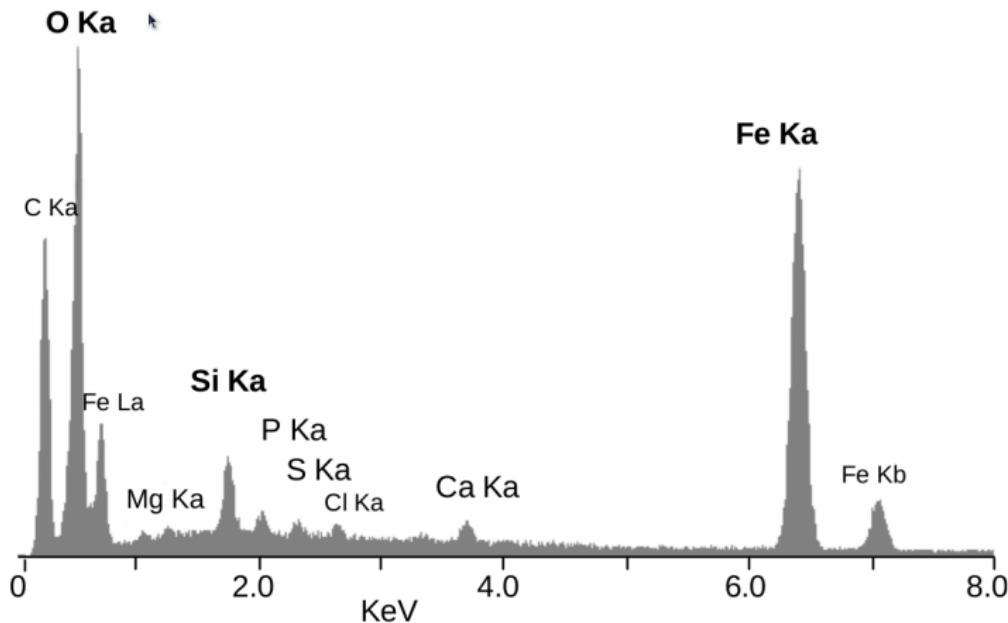
Obrázek: Kanálovací kontrast - různá orientace krystalových zrn (Al+Cu).

# X-Ray mikroanalýza



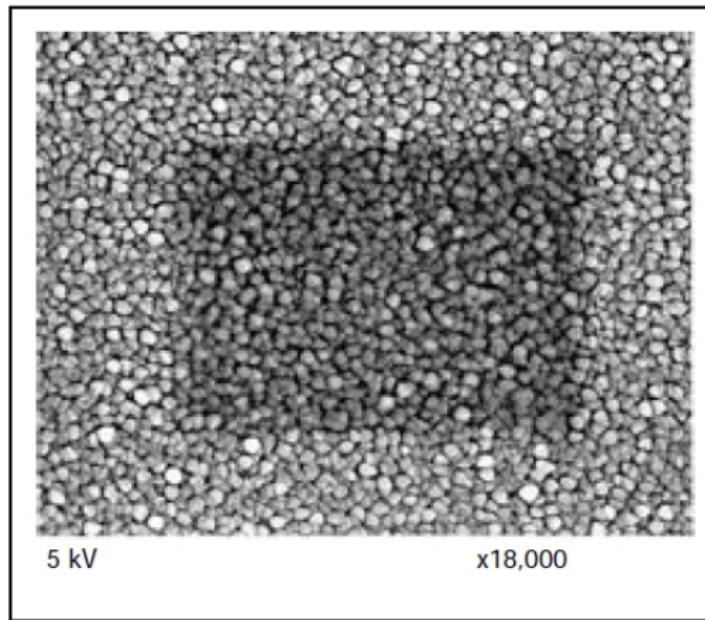
- ▶ Vyražení elektronu z atomu terče
- ▶ Charakteristické rentgenové záření
- ▶ Prvková analýza
- ▶ Poměrně velký informační objem
- ▶ Detektory EDX a WDX

# EDX spektrum



Obrázek: Typický příklad zaznamenaného EDX spektra.

# Kontaminace



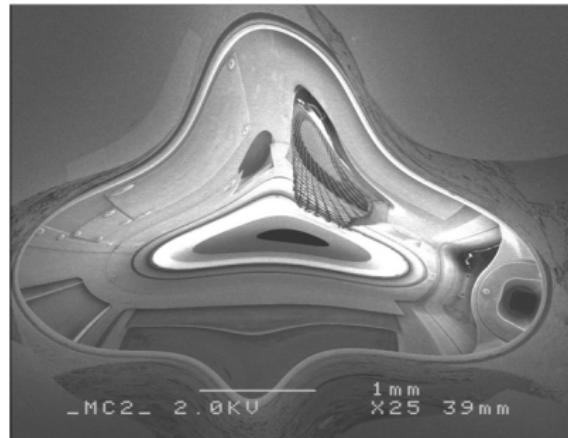
Obrázek: Kontaminace vzorku.

# Kontaminace

- ▶ Kontaminace je organická vrstva deponovaná pod elektronovým svazkem
- ▶ Kontaminaci se dá předcházet
  - ▶ Maximální čistota práce uvnitř vakuové komory
  - ▶ Plazmové dekontaminátory
- ▶ Pro vyšší urychlovací napětí kontaminace průhledná

## Nabíjení vzorku

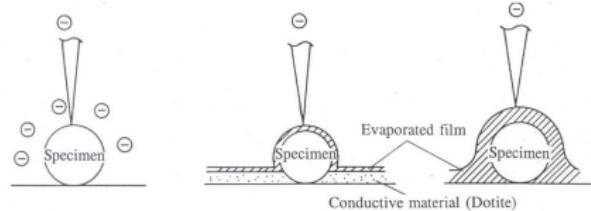
- ▶ Nevodivé vzorky se v elektronovém mikroskopu zpravidla nabíjí



Obrázek: Pozorování nabité kovové mikrotečky svazkem na 2keV.

## Nabíjení vzorku - řešení

- ▶ Pokovení vzorku
- ▶ Ztráta jemné topografické informace
- ▶ Nepohodlné

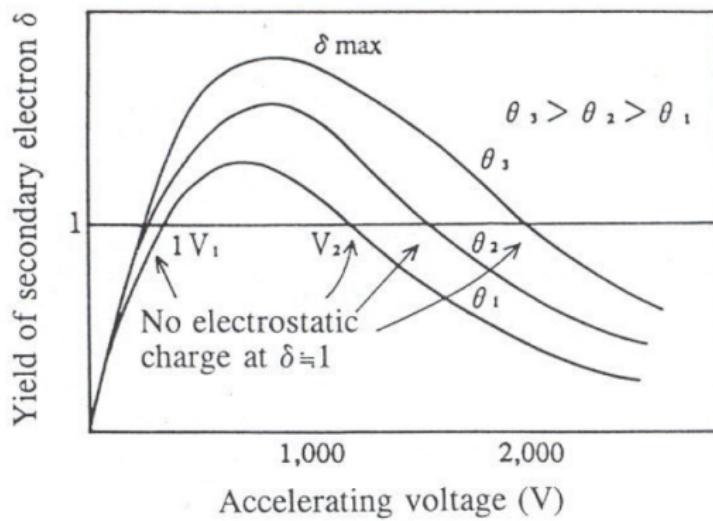


## Nabíjení vzorku - řešení

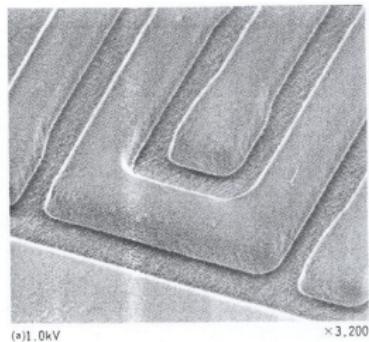
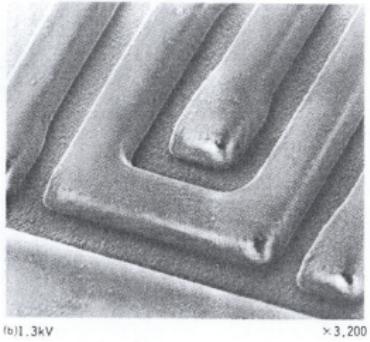
- ▶ Práce v nízkém vakuu
- ▶ Ionizovaný plyn odvádí náboj ze vzorku
- ▶ Potřeba přívodu čistého dusíku nebo vodních par
- ▶ Potřeba speciálního detektoru SE
- ▶ Nižší rozlišení kvůli "skirt efektu"
- ▶ Časově a psychicky náročnější

# Nabíjení vzorku - řešení

- ▶ Vyladění urychlovacího napětí
- ▶ Na nízkých HV přestává být nabíjení vzorku problém



## Nabíjení vzorku - řešení



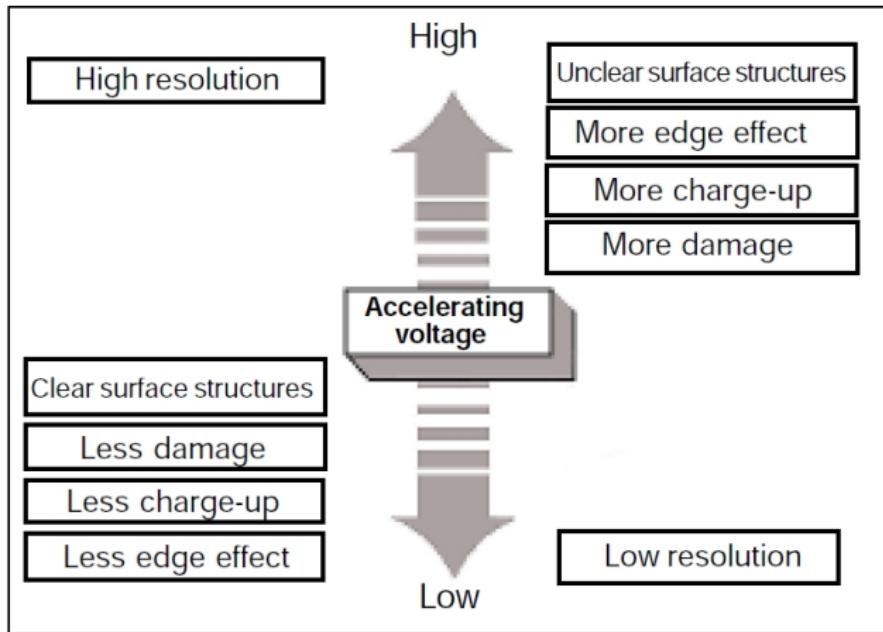
Specimen: Photoresist on an IC pattern  
Electrostatic charge is eliminated at an appropriate accelerating voltage.

**Obrázek:** Nabíjení fotorezistu je eliminováno zvolením správného urychlovacího napětí.

# Typické proměnné při práci se SEM

- ▶ Urychlovací napětí (HV - high voltage)
- ▶ Pracovní vzdálenost (WD - working distance)
- ▶ Proud svazkem (BI - beam intensity)

# Efekt změny HV



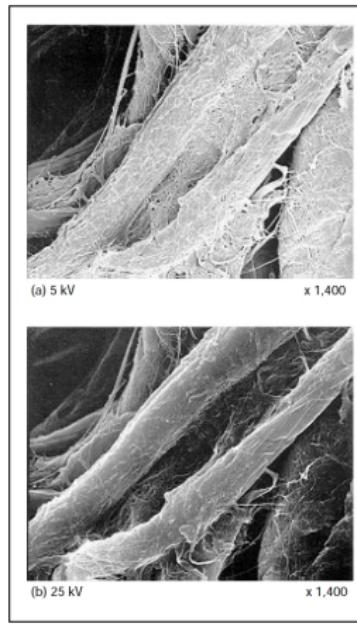
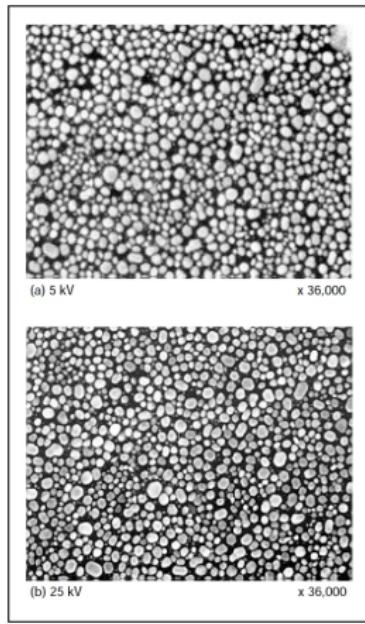
# Efekt změny HV

Proč je na vyšším HV vyšší rozlišení?

Chromatická vada:

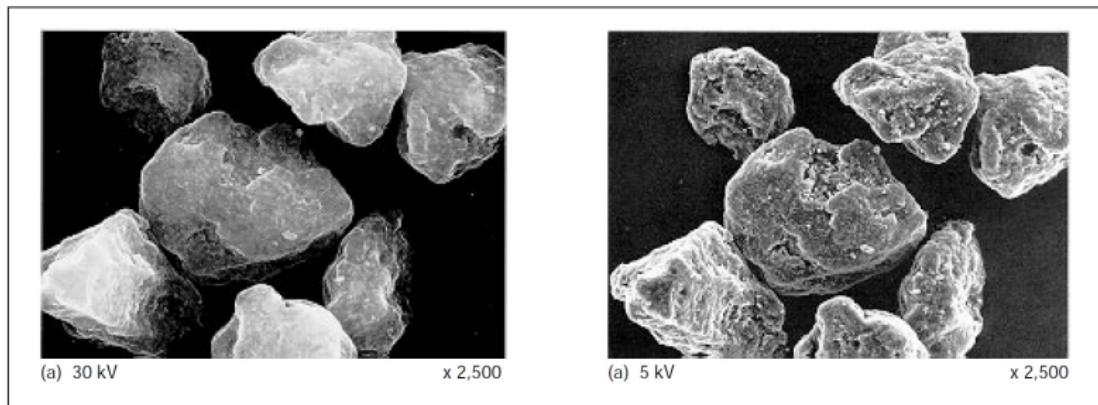
$$d_c = C_c \alpha \left( \frac{\Delta E}{E_0} \right)$$

## Efekt změny HV



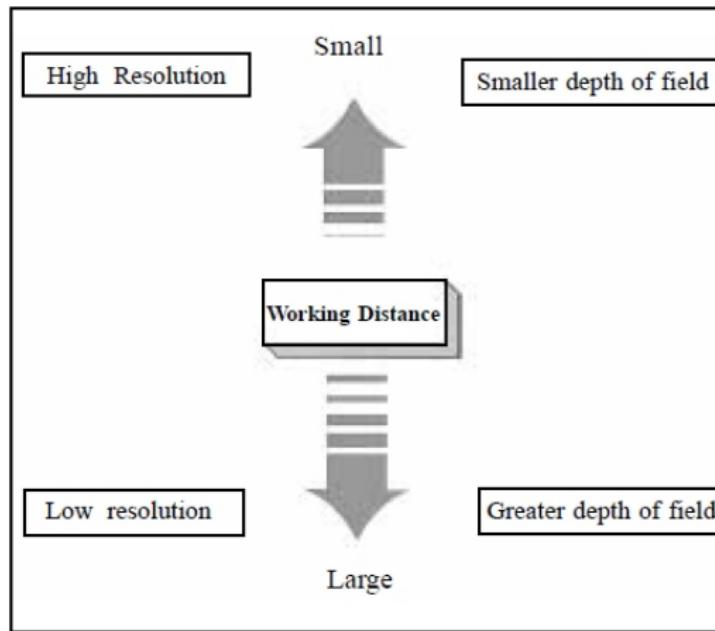
Obrázek: Efekt změny HV na dvou vzorcích (zlato na uhlíku a papír).

# Efekt změny HV

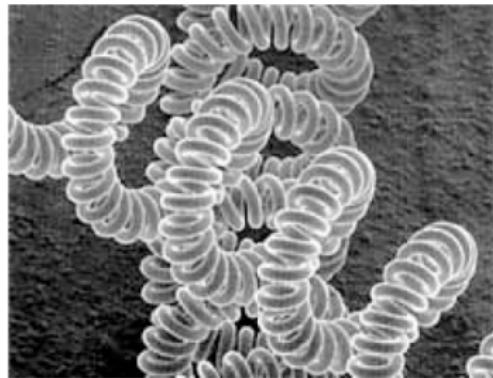


Obrázek: Efekt změny HV na obrázcích toneru.

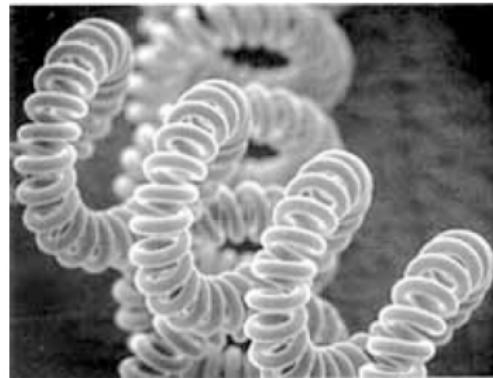
# Efekt změny WD



## Efekt změny WD

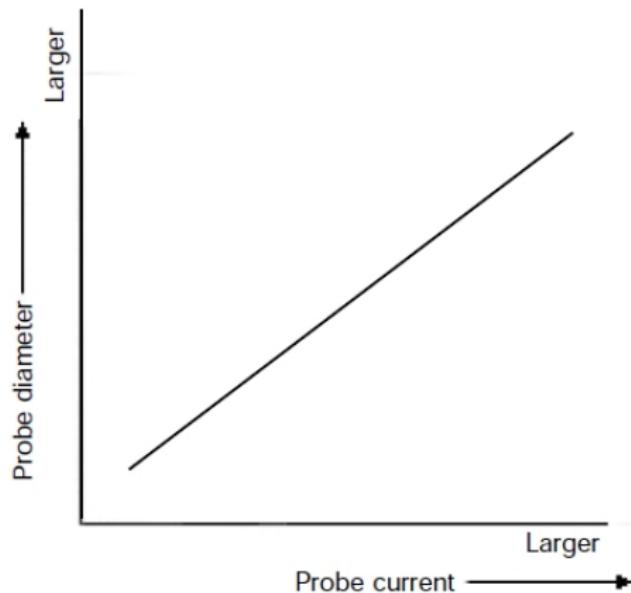


Obrázek: Malá WD, malá apertura, vysoká hloubka ostrosti.

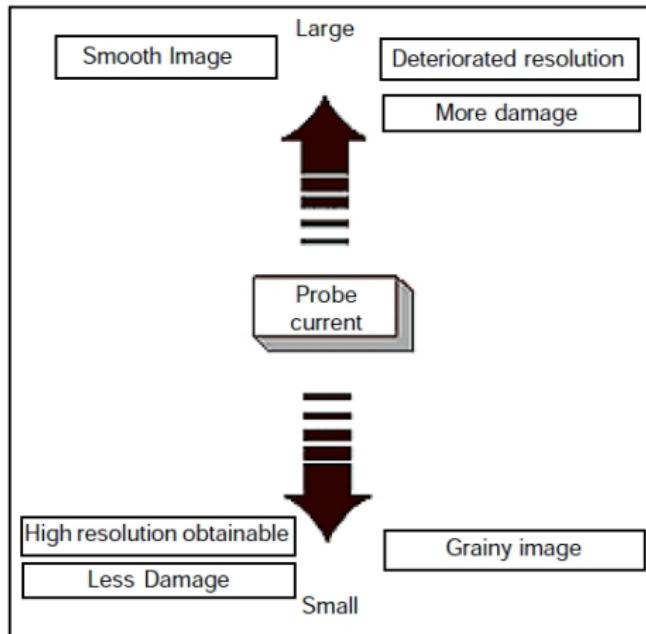


Obrázek: Velká WD, velká apertura, nízká hloubka ostrosti.

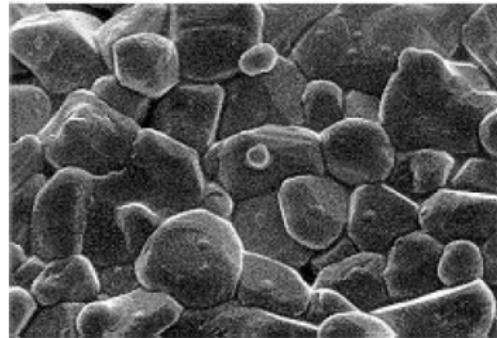
# Efekt změny BI



# Efekt změny BI

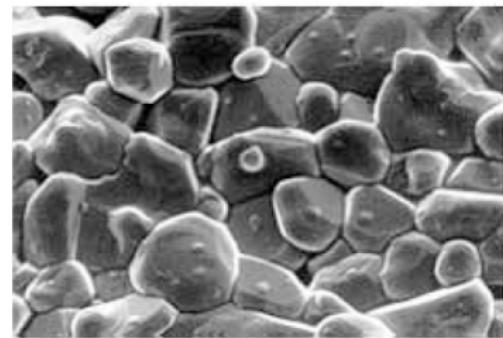


# Efekt změny BI



(c) 10 pA

Obrázek: Proud svazkem 10 pA.



(a) 1 nA

Obrázek: Proud svazkem 1 nA.

# DĚKUJI ZA POZORNOST

